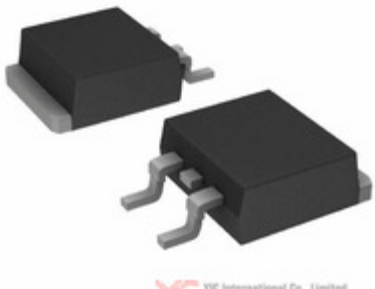









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80N04S3-03</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N04S3-03.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2400 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N04S3-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N04S3-03 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N04S3-03-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N04S3-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80N04S3-03 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB80N04S2L-03</b> I IPB80N04S2L-03 I</p>	 <p><b>IPB80N04S3-H4</b> INFINEO IPB80N04S3-H4 INFINEO</p>	 <p><b>IPB80N04S204ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N04S2L03ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>
 <p><b>IPB80N04S3-04</b> INFINEO IPB80N04S3-04 INFINEO</p>	 <p><b>IPB80N04S304ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N04S2H4ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N04S303ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80N04S3-03 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N04S3-03 Datenblatt	IPB80N04S3-03-Datenblätter	IPB80N04S3-03 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N04S3-03
IPB80N04S3-03 Electronic	IPB80N04S3-03-Komponenten	IPB80N04S3-03-Verteiler	IPB80N04S3-03-Bild	IPB80N04S3-03-Teil
IPB80N04S3-03 Preis	IPB80N04S3-03 Hersteller	IPB80N04S3-03 Bild	IPB80N04S3-03 Aktie	IPB80N04S3-03 Inventar
IPB80N04S3-03 Neu	IPB80N04S3-03 Original	IPB80N04S3-03 garantiert	IPB80N04S3-03 RFQ	IPB80N04S3-03 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited